

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Band: 89 (1971)
Heft: 2

Artikel: Siliziumkarbid als Halbleitermaterial
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-84732>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

27. Sept. 1962, veranstaltet von der Eidg. Kommission für Luft-hygiene. «Industrielle Organisation», 31 (1962), Nr. 11, S. 325 ff.

- [16] Brunner M.: Die Zusammensetzung der Auspuffgase bei Benzinmotoren (Der Einfluss der Treibstoffzusammensetzung). «Zeitschr. für Präventivmedizin» 1966, Heft 2, S. 77 ff.
- [17] Wiethaup H.: Die rechtliche Seite der Luftverunreinigung durch den Hausbrand. «Staub», Vol. 25, Nr. 3, März 1965.
- [18] Liesegang W.: Der Flugascheauswurf vom Standpunkte des Nachbarnschutzes. «Staub» 1953, Heft 31, S. 29 ff.

[19] Hess W.: Emissionen aus Ölfeuerungen in Zürich. «Staub», Vol. 25, Nr. 11, November 1965.

[20] Sawyer R.F.: Fundamental Processes Controlling the Air Pollution Emissions from Turbojet Engines. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 6th Annual Meeting, Anaheim, California, October 20–24, 1969. AIAA-Paper Nr. 69-1040.

Adresse des Verfassers: E. F. Schiantarelli, dipl. Chemiker, Leiter der Abt. Materialprüfung und Verfahren, Swissair, Schweiz. Luftverkehr AG, 8058 Zürich-Flughafen.

Siliziumkarbid als Halbleitermaterial

DK 661:621.315.59

Seit der Erfindung des Transistors durch Shockley im Jahr 1947 haben Halbleiterbauelemente immer grössere Bedeutung erlangt und zu einer stürmischen Entwicklung vor allem der Nachrichten-, aber auch der Starkstrom-technik geführt. Die Grundlagen zu dieser Entwicklung lieferte die Erforschung der Eigenschaften der verwendeten Halbleitermaterialien, d. h. zunächst des Germaniums und später des Siliziums. Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelementes sind durch das verwendete Halbleitermaterial bestimmt. Die Erforschung weiterer Materialien ist daher der Schlüssel zur Entwicklung von Bauelementen mit besseren oder ganz neuen Eigenschaften.

Zu den Materialien, die neue technische Anwendungen versprechen, gehört das Siliziumkarbid (SiC). Seine hervorstechenden Eigenschaften sind seine hohe Temperaturbeständigkeit, die grosse Breite seiner verbotenen Zone, seine chemische Beständigkeit und seine Härte. Um die Halbleitereigenschaften eines Materials auszunutzen, muss man es in einkristalliner Form und in äusserster Reinheit herstellen. Die gleichen Eigenschaften, die SiC gegenüber anderen Halbleitermaterialien auszeichnen, insbesondere seine Temperaturbeständigkeit, bedingen für die Herstellung

genügend reiner Einkristalle aus SiC einen erheblichen Aufwand. SiC-Einkristalle werden aus hochreinem polykristallinem SiC durch Umsublimation (SiC lässt sich nicht schmelzen) bei 2500 °C unter niederem Druck gezogen. Es werden so höhere Reinheiten als 1 ppm (ein Verunreinigungsatom auf 10⁶ Si- und 10⁶ C-Atome) erzielt.

Eine andere Möglichkeit, sehr reine Einkristalle aus SiC zu erhalten, stellt die Epitaxie aus der Gasphase dar. Das Kristallwachstum lässt sich dabei besser beherrschen, weil es bei nicht so hohen Temperaturen erfolgt. Dieses Verfahren wird im Brown-Boveri-Konzern-Forschungszentrum benutzt, um *p-n*-Übergänge zu erhalten. Ein *n*-dotierter SiC-Einkristall wird in einer Wasserstoffatmosphäre auf 1750 °C erhitzt. Dem Wasserstoff werden geringe Mengen von kohlenstoff-, silizium- und borhaltigen Gasen beigemischt, die sich bei der hohen Temperatur zersetzen. Dabei wächst auf dem Grundkristall (Substrat genannt) eine *p*-dotierte SiC-Schicht einkristallin auf. Mit diesem Verfahren erhielt man Dioden, die bei Zimmertemperatur bis zu 500 V sperren und bis zu Temperaturen von 500 °C gleichrichten. Mit solchen Dioden gelang es, α -Strahlen in einem Reaktor bei 400 °C nachzuweisen.

Mart Stam

DK 92:72

Von Martin Steinmann, Zürich

Die folgenden Anmerkungen über die Beziehungen von Mart Stam zur Schweiz wurden als Einführung der Ausstellung Mart Stam in der ETH Zürich gemacht (SBZ 1970, H. 50, S. 1185). Mart Stam lebt zurückgezogen «irgendwo in der Schweiz» und lehnte alle Versuche ab, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Anmerkungen stützen sich deshalb auf die Mitteilungen von Hans Schmidt, Werner Moser † und Emil Roth.

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeiteten verschiedene schweizerische Architekten für einige Zeit in Holland, das sich aus dem Weltkrieg heraushalten und ohne Unterbrechung durch schwere wirtschaftliche Schädigung die Erneuerung der Architektur weiterführen konnte, welche von Berlage ausging. Die Architektur in der Schweiz stand damals noch unter dem Einfluss der Sechs Bücher vom Bauen von Ostendorf, welche einen betont bürgerlichen Stil vertraten, anlehnend an die nachrevolutionäre Architektur um 1800.

Hans Schmidt arbeitete 1920–22 in Holland, Werner Moser 1922–23, beide eine Zeit zusammen bei Granpré-Molière in Rotterdam, bei welchem Mart Stam 1919–22 angestellt war. Mart Stam vermittelte den beiden Schweizern «viel vom einfachen holländischen Leben, aus welchem er kam» und dadurch von den gesellschaftlichen Grundlagen der neuen Architektur. In Rotterdam standen auch schon die ersten der vorbildlichen Mietshäuser von Oud, welche den städtischen Massenwohnungsbau als entscheidende Aufgabe der Zwanziger Jahre in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht ankündigten.

1922–23 schrieb Mart Stam auf Vermittlung von Hans Schmidt einen längeren Aufsatz über «Holland und die Baukunst unserer Zeit» für die SBZ, welcher in vier Folgen 1923

erschien als erste Arbeit über die Absichten der neuen Architektur¹⁾. Anlass für die Veröffentlichung war gemäss einem redaktionellen Vorwort «die unverkennbaren Rückwirkungen der holländischen Entwicklung auf die schweizerische Architektur und die daraus erwachsenden Meinungsverschiedenheiten». Solche Rückwirkungen zeigten sich in verschiedenen Wettbewerben in Form von «verschobenen», nicht auf Achsen angelegten Baukörpern, welche auch kurzerhand als «Eisenbahnunglücke» bezeichnet wurden.

Beim Erscheinen der vier Folgen arbeitete Mart Stam in Zürich bei Prof. Karl Moser an den Ausführungsplänen für das Haus Rickli an der Herzogstrasse, an welchem sich die Ausbildung der Fenster unschwer als Stams Arbeit nachweisen lässt, vor allem am Vorbau, an welchem Sturz und Brüstung in der Art von Klijnen als schmale Streifen durchgezogen und um die Ecke geführt werden. Zusammen mit seiner Frau bewohnte Stam ein Zimmer im Dachstock des Hauses von Prof. Karl Moser an der Freudenbergstrasse.

Reyner Banham stellt in «Theory and Design of the First Machine Age» den Entschluss von Mart Stam, in der Schweiz zu arbeiten, so dar, dass er dem befreundeten El Lissitzky nachgereist sei, welcher 1924–25 in Agra (Tessin) eine Lungentuberkulose ausheilte. Ein Brief von Lissitzky über seine Durchreise in Zürich widerlegt diese Vermutung: «Am Bahnhof Zürich wurde ich von dem grossen Pra – Umkehrung von Arp – in weissen Locken und dem anderthalb Kilometer langen Stam abgeholt», und weiter unten: «Der Stam macht hier Revolution

¹⁾ SBZ 1923 Bd. 82, H. 15 (S. 185), H. 18 (S. 225), H. 19 (S. 241), H. 21 (S. 268). Daran schliesst sich eine Kontroverse zwischen Arch. E. Wipf (H. 24, S. 317) und Mart Stam (H. 26, S. 339).